

$$A \in T1$$

17.52020
BRE

Wdg. - Arbeitspunkt (DC)

- Transitionen

MOSFET N+P-Kanal
Selbstsperrend

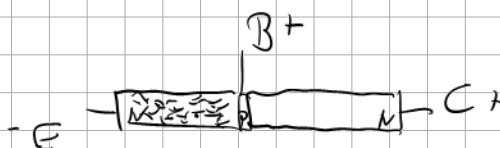
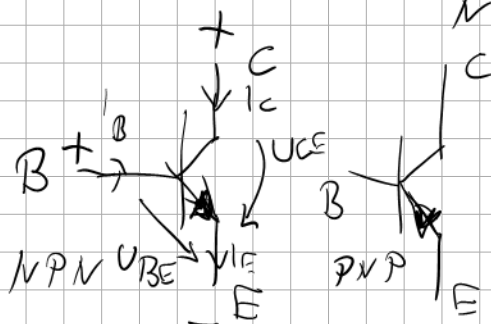
$NP \neq P/NP$

JFET N-Channel

Transistoren (Fests.)

NPN / PNP

Bipolartransistoren



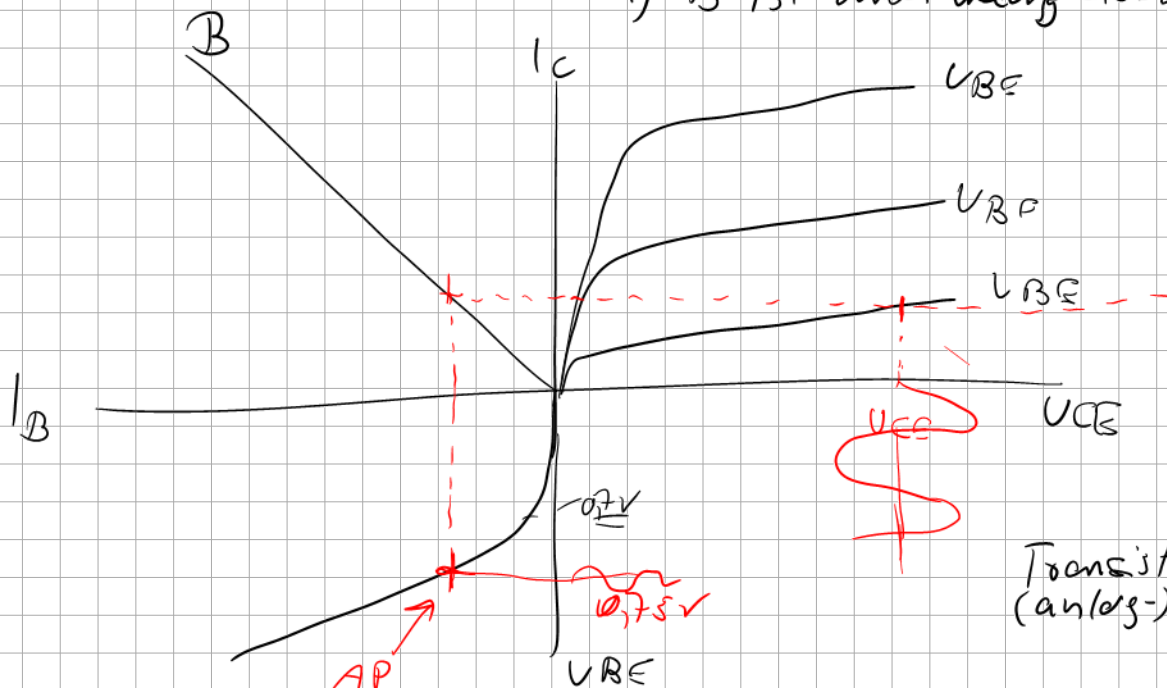
- Ein kleiner Basisstrom löst großen Kollektorstrom aus.

- Stromverstärkungsfaktor $\beta = \frac{I_C}{I_B}$
(10... 700)

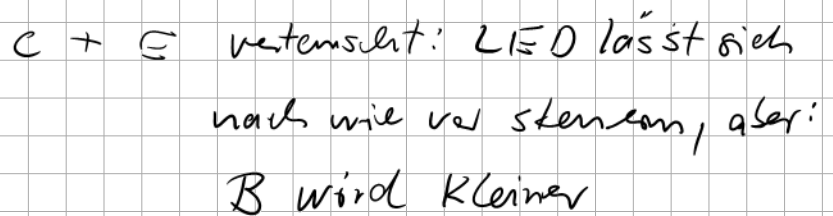
$$1_E = 1_C + 1_B = 1_C + \frac{1_C}{B} \approx 1_C$$

sehr klein

- 1) B ist sehr schmal
- 2) E ist sehr hoch dotiert
- 3) C ist am wenigsten dotiert
- 4) B ist auch wenig dotiert



Transistor als
(analog-) Verstärker



Penlighten $B > 10000$